



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0075503
(43) 공개일자 2019년07월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 51/52 (2006.01) *H01L 51/56* (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01L 51/5237 (2013.01)
H01L 51/5203 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2017-0177133
(22) 출원일자 2017년12월21일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘지디스플레이 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)
(72) 발명자
김태경
경기도 파주시 월롱면 엘지로 245
(74) 대리인
특허법인천문

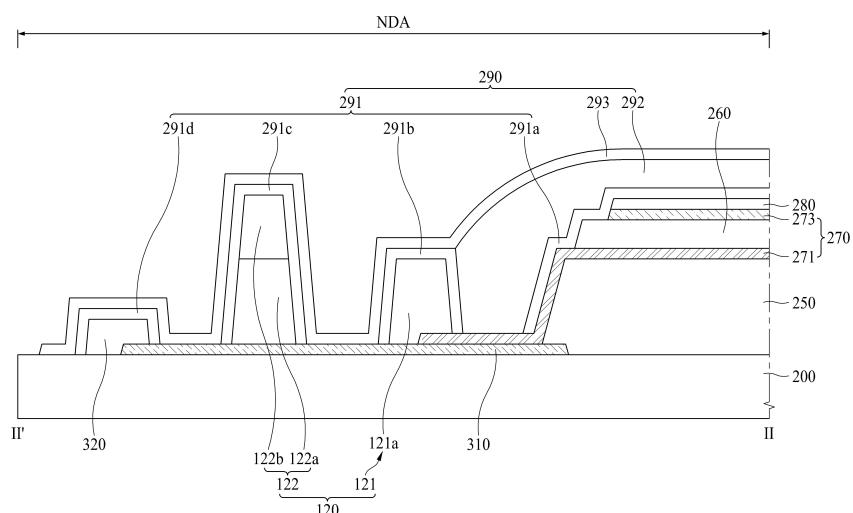
전체 청구항 수 : 총 12 항

(54) 발명의 명칭 표시장치

(57) 요 약

본 발명은 수분이 표시영역에 배치된 유기발광소자로 확산되는 것을 방지할 수 있는 표시장치를 제공한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치는 표시 영역, 및 표시 영역을 둘러싸는 비표시 영역을 포함하는 기판, 표시 영역에 배치되고, 제1 전극, 유기발광층 및 제2 전극을 포함하는 유기발광소자, 비표시 영역에서 표시 영역을 둘러싸도록 형성된 댐, 유기발광소자 상에 패턴 형성된 제1 패턴, 및 제1 패턴과 동일한 물질로 댐 상에 패턴 형성된 제2 패턴을 포함한다.

대 표 도



(52) CPC특허분류
H01L 51/56 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

표시 영역, 및 상기 표시 영역을 둘러싸는 비표시 영역을 포함하는 기판;
상기 표시 영역에 배치되고, 제1 전극, 유기발광층 및 제2 전극을 포함하는 유기발광소자;
상기 비표시 영역에서 상기 표시 영역을 둘러싸도록 형성된 댐;
상기 유기발광소자 상에 패턴 형성된 제1 패턴; 및
상기 제1 패턴과 동일한 무기 물질로 상기 댐 상에 패턴 형성된 제2 패턴을 포함하는 표시장치.

청구항 2

제1항에 있어서,
상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴은 이격 배치되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 3

제1항에 있어서,
상기 제2 패턴은 상기 댐 상에 직접 형성되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 4

제1항에 있어서,
상기 유기발광소자 상에 배치되고, 적어도 하나의 무기막을 포함하는 봉지막을 더 포함하고,
상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴은 상기 봉지막의 적어도 하나의 무기막인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 5

제4항에 있어서,
상기 봉지막은,
상기 유기발광소자 상에 배치된 제1 무기막;
상기 제1 무기막 상에 배치된 유기막; 및
상기 유기막 상에 배치된 제2 무기막을 포함하고,
상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴은 상기 제1 무기막인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 6

제5항에 있어서,
상기 제2 무기막은 상기 유기막 및 상기 제1 무기막을 덮도록 형성되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 7

제1항에 있어서,
상기 유기발광소자 상에 형성된 캡핑층을 더 포함하고,
상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴은 상기 캡핑층인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 캡핑층은,

상기 제2 전극 상에 배치되고, 유기 물질로 이루어진 제2 캡핑층; 및

상기 제2 캡핑층 상에 배치되고, 무기 물질로 이루어진 제1 캡핑층을 포함하고,

상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴은 상기 제1 캡핑층인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 제2 캡핑층은 상기 제1 캡핑층에 의하여 덮히는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 10

제7항에 있어서,

상기 제2 전극은 상기 캡핑층과 중첩되어 동일한 면적을 가지도록 형성되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 11

제1항에 있어서,

상기 비표시 영역에 배치되고, 상기 유기발광소자에 전원 전압을 공급하는 전원 라인; 및

상기 전원 라인의 가장자리를 덮도록 형성된 유기보호막을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 제1 및 제2 패턴과 동일한 물질로 상기 유기보호막 상에 패턴 형성된 제3 패턴을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 표시장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 정보화 사회가 발전함에 따라 영상을 표시하기 위한 표시장치에 관한 요구가 다양한 형태로 증가하고 있다. 이에 따라, 최근에는 액정표시장치(LCD: Liquid Crystal Display), 플라즈마표시장치(PDP: Plasma Display Panel), 유기발광표시장치(OLED: Organic Light Emitting Display)와 같은 여러가지 표시장치가 활용되고 있다.

[0003] 표시장치들 중에서 유기발광표시장치는 자체발광형으로서, 액정표시장치(LCD)에 비해 시야각, 대조비 등이 우수하며, 별도의 백라이트가 필요하지 않아 경량 박형이 가능하며, 소비전력이 유리한 장점이 있다. 또한, 유기발광표시장치는 직류저전압 구동이 가능하고, 응답속도가 빠르며, 특히 제조비용이 저렴한 장점이 있다.

[0004] 유기발광표시장치는 유기발광소자를 각각 포함하는 화소들, 및 화소들을 정의하기 위해 화소들을 구획하는 뱅크를 포함한다. 뱅크는 화소 정의막으로 역할을 할 수 있다. 유기발광소자는 애노드 전극, 정공 수송층(hole transporting layer), 유기발광층(organic light emitting layer), 전자 수송층(electron transporting layer), 및 캐소드 전극을 포함한다. 이 경우, 애노드 전극에 고전위 전압이 인가되고 캐소드 전극에 저전위 전압이 인가되면 정공과 전자가 각각 정공 수송층과 전자 수송층을 통해 유기발광층으로 이동되며, 유기발광층에서 서로 결합하여 발광하게 된다.

[0005] 유기발광소자는 외부의 수분, 산소와 같은 외적 요인에 의해 쉽게 열화가 일어나는 단점이 있다. 이를 방지하기 위하여, 유기발광표시장치는 외부의 수분, 산소가 유기발광소자에 침투되지 않도록 봉지막을 형성한다. 봉지막

은 적어도 하나의 무기막 및 적어도 하나의 유기막을 포함한다.

[0006] 유기막은 일반적으로 폴리머(polymer)로 구성되며, 액상 형태로 기판 상에 도포된 후 경화 공정을 거쳐 형성된다. 이러한 유기막은 경화 전까지 유동성이 있기 때문에 봉지막을 형성하고자 하는 영역 밖으로 흘러넘치는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 최근에는 유기발광소자의 외곽을 따라 유기막의 흐름을 차단하는 댐을 형성하고 있다.

[0007] 봉지막을 구성하는 유기막은 댐에 의하여 흐름이 차단되므로, 댐 내부에 형성된다. 반면, 봉지막을 구성하는 무기막은 유기막은 물론 댐을 덮도록 형성된다. 댐은 일반적으로 유기물질로 이루어진다. 이때, 유기물질로 이루어진 댐은 봉지막을 구성하는 무기막 간의 계면 접착력이 약하여 계면이 들뜨는 경우가 발생한다. 이와 같은 계면 들뜸으로 인하여 수분 또는 산소가 투입될 수 있으며, 투입된 수분이 무기막을 따라 유기발광소자까지 확산될 수 있다. 수분은 유기발광층 및 캐소드 전극에까지 침투하여 산화시킴에 따라 유기발광소자에 열화가 발생한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명은 수분이 표시영역에 배치된 유기발광소자로 확산되는 것을 방지할 수 있는 표시장치를 제공한다.

과제의 해결 수단

[0009] 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치는 표시 영역, 및 표시 영역을 둘러싸는 비표시 영역을 포함하는 기판, 표시 영역에 배치되고, 제1 전극, 유기발광층 및 제2 전극을 포함하는 유기발광소자, 비표시 영역에서 표시 영역을 둘러싸도록 형성된 댐, 유기발광소자 상에 패턴 형성된 제1 패턴, 및 제1 패턴과 동일한 물질로 댐 상에 패턴 형성된 제2 패턴을 포함한다.

발명의 효과

[0010] 본 발명에 따르면, 봉지막을 구성하는 제1 무기막을 패턴 형성할 수 있다. 본 발명은 댐 상에 형성된 제1 무기막과 유기발광소자 상에 형성된 제1 무기막을 이격 배치함으로써, 댐 상에 형성된 제1 무기막에 수분이 침투하더라도 유기발광소자로 확산되는 것을 방지할 수 있다.

[0011] 또한, 본 발명은 댐과 제1 무기막 사이에 캡핑층을 형성할 수 있다. 댐과 캡핑층 사이의 계면 접착력이 댐과 제1 무기막 사이의 계면 접착력 보다 높게 나타나므로, 본 발명은 댐에서의 계면 접착력을 향상시킬 수 있다. 이에 따라, 본 발명은 댐에서의 계면 들뜸을 방지할 수 있다.

[0012] 또한, 본 발명은 댐과 제1 무기막 사이에 캡핑층을 패턴 형성할 수 있다. 본 발명은 댐 상에 형성된 캡핑층과 유기발광소자 상에 형성된 캡핑층을 이격 배치함으로써, 댐 상에 형성된 캡핑층에 수분이 침투하더라도 유기발광소자로 확산되는 것을 방지할 수 있다.

[0013] 또한, 본 발명은 캡핑층과 제2 전극을 하나의 마스크를 이용하여 동일한 면적을 가지도록 형성할 수 있다. 이에 따라, 본 발명은 제조 비용을 절감할 수 있다.

[0014] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

[0015] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치를 보여주는 사시도이다.

도 2는 도 1의 제1 기판, 소스 드라이브 IC, 연성필름, 회로보드, 및 타이밍 제어부를 보여주는 평면도이다.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 제1 기판을 개략적으로 보여주는 평면도이다.

도 4는 도 3의 표시 영역의 화소의 일 예를 보여주는 단면도이다.

도 5는 도 3에 도시된 II-II' 선의 제1 실시예를 나타내는 단면도이다.

도 6은 도 3에 도시된 Ⅱ-Ⅱ' 선의 제2 실시예를 나타내는 단면도이다.

도 7은 도 6의 변형된 실시예를 나타내는 도면이다.

도 8은 도 3에 도시된 Ⅱ-Ⅱ' 선의 제3 실시예를 나타내는 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0016] 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.

[0017] 본 발명의 실시 예를 설명하기 위한 도면에 개시된 형상, 크기, 비율, 각도, 개수 등은 예시적인 것으로 본 발명이 도시된 사항에 한정되는 것은 아니다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다.

[0018] 본 명세서에서 언급된 '포함한다', '갖는다', '이루어진다' 등이 사용되는 경우 '~만'이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별히 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함한다.

[0019] 구성 요소를 해석함에 있어서, 별도의 명시적 기재가 없더라도 오차 범위를 포함하는 것으로 해석한다.

[0020] 위치 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~상에', '~상부에', '~하부에', '~옆에' 등으로 두 부분의 위치 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않는 이상 두 부분 사이에 하나 이상의 다른 부분이 위치할 수도 있다.

[0021] 시간 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~후에', '~에 이어서', '~다음에', '~전에' 등으로 시간적 선후 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.

[0022] 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않는다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있다.

[0023] "X축 방향", "Y축 방향" 및 "Z축 방향"은 서로 간의 관계가 수직으로 이루어진 기하학적인 관계만으로 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 구성이 기능적으로 작용할 수 있는 범위 내에서보다 넓은 방향성을 가지는 것을 의미할 수 있다.

[0024] "적어도 하나"의 용어는 하나 이상의 관련 항목으로부터 제시 가능한 모든 조합을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, "제 1 항목, 제 2 항목 및 제 3 항목 중에서 적어도 하나"의 의미는 제 1 항목, 제 2 항목 또는 제 3 항목 각각 뿐만 아니라 제 1 항목, 제 2 항목 및 제 3 항목 중에서 2개 이상으로부터 제시될 수 있는 모든 항목의 조합을 의미할 수 있다.

[0025] 본 발명의 여러 실시 예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하고, 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시 예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관 관계로 함께 실시할 수도 있다.

[0026] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다.

[0027] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치를 보여주는 사시도이다. 도 2는 도 1의 제1 기판, 소스 드라이브 IC, 연성필름, 회로보드, 및 타이밍 제어부를 보여주는 평면도이다.

[0028] 이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치가 유기발광표시장치(Organic Light Emitting Display)인 것을 중심으로 설명하였으나, 이에 한정되지 않는다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치는 유기발광표시장치뿐만 아니라, 액정표시장치(Liquid Crystal Display), 전계 방출 표시장치(Field Emission Display), 퀀텀닷 발광표시장치 (Quantum dot Lighting Emitting Diode) 및 전기영동 표시장치(Electrophoresis display) 중 어느 하나로 구현될 수도 있다.

- [0029] 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 표시장치(100)는 표시패널(110), 소스 드라이브 칩적회로(integrated circuit, 이하 "IC"라 칭함)(140), 연성필름(150), 회로보드(160), 및 타이밍 제어부(170)를 포함한다.
- [0030] 표시패널(110)은 제1 기판(111)과 제2 기판(112)을 포함한다. 제2 기판(112)은 봉지 기판일 수 있다. 제1 기판(111)은 플라스틱 필름(plastic film) 또는 유리 기판(glass substrate)일 수 있다. 제2 기판(112)은 플라스틱 필름, 유리 기판, 또는 봉지 필름일 수 있다.
- [0031] 제2 기판(112)과 마주보는 제1 기판(111)의 일면 상에는 게이트 라인들, 데이터 라인들, 및 화소들이 형성된다. 화소들은 게이트 라인들과 데이터 라인들의 교차 구조에 의해 정의되는 영역에 마련된다.
- [0032] 화소들 각각은 박막 트랜지스터와 제1 전극, 유기발광층, 및 제2 전극을 구비하는 유기발광소자를 포함할 수 있다. 화소들 각각은 박막 트랜지스터를 이용하여 게이트 라인으로부터 게이트 신호가 입력되는 경우 데이터 라인의 데이터 전압에 따라 유기발광소자에 소정의 전류를 공급한다. 이로 인해, 화소들 각각의 유기발광소자는 소정의 전류에 따라 소정의 밝기로 발광할 수 있다. 화소들 각각의 구조에 대한 설명은 도 4을 결부하여 후술한다.
- [0033] 표시패널(110)은 화소들이 형성되어 화상을 표시하는 표시 영역(DA)과 화상을 표시하지 않는 비표시 영역(NDA)으로 구분될 수 있다. 표시 영역(DA)에는 게이트 라인들, 데이터 라인들, 및 화소들이 형성될 수 있다. 비표시 영역(NDA)에는 게이트 구동부 및 패드들이 형성될 수 있다.
- [0034] 게이트 구동부는 타이밍 제어부(170)로부터 입력되는 게이트 제어신호에 따라 게이트 라인들에 게이트 신호들을 공급한다. 게이트 구동부는 표시패널(110)의 표시 영역(DA)의 일측 또는 양측 바깥쪽의 비표시 영역(DA)에 GIP(gate driver in panel) 방식으로 형성될 수 있다. 또는, 게이트 구동부는 구동 칩으로 제작되어 연성필름에 실장되고 TAB(tape automated bonding) 방식으로 표시패널(110)의 표시 영역(DA)의 일측 또는 양측 바깥쪽의 비표시 영역(DA)에 부착될 수도 있다.
- [0035] 소스 드라이브 IC(140)는 타이밍 제어부(170)로부터 디지털 비디오 데이터와 소스 제어신호를 입력받는다. 소스 드라이브 IC(140)는 소스 제어신호에 따라 디지털 비디오 데이터를 아날로그 데이터전압들로 변환하여 데이터 라인들에 공급한다. 소스 드라이브 IC(140)가 구동 칩으로 제작되는 경우, COF(chip on film) 또는 COP(chip on plastic) 방식으로 연성필름(150)에 실장될 수 있다.
- [0036] 표시패널(110)의 비표시 영역(NDA)에는 데이터 패드들과 같은 패드들이 형성될 수 있다. 연성필름(150)에는 패드들과 소스 드라이브 IC(140)를 연결하는 배선들, 패드들과 회로보드(160)의 배선들을 연결하는 배선들이 형성될 수 있다. 연성필름(150)은 이방성 도전 필름(antisotropic conducting film)을 이용하여 패드들 상에 부착되며, 이로 인해 패드들과 연성필름(150)의 배선들이 연결될 수 있다.
- [0037] 회로보드(160)는 연성필름(150)들에 부착될 수 있다. 회로보드(160)는 구동 칩들로 구현된 다수의 회로들이 실장될 수 있다. 예를 들어, 회로보드(160)에는 타이밍 제어부(170)가 실장될 수 있다. 회로보드(160)는 인쇄회로 보드(printed circuit board) 또는 연성 인쇄회로보드(flexible printed circuit board)일 수 있다.
- [0038] 타이밍 제어부(170)는 회로보드(160)의 케이블을 통해 외부의 시스템 보드로부터 디지털 비디오 데이터와 타이밍 신호를 입력 받는다. 타이밍 제어부(170)는 타이밍 신호에 기초하여 게이트 구동부의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 제어신호와 소스 드라이브 IC(140)들을 제어하기 위한 소스 제어신호를 발생한다. 타이밍 제어부(170)는 게이트 제어신호를 게이트 구동부에 공급하고, 소스 제어신호를 소스 드라이브 IC(140)들에 공급한다.
- [0040] **제1 실시예**
- [0041] 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 제1 기판을 개략적으로 보여주는 평면도이다.
- [0042] 도 3을 참조하면, 제1 기판(111)은 표시 영역(DA)과 비표시 영역(NDA)으로 구분되며, 비표시 영역(NDA)에는 패드들이 형성되는 패드 영역(PA)이 형성될 수 있다.
- [0043] 표시 영역(DA)에는 데이터 라인들, 데이터 라인들과 교차되는 게이트 라인들이 형성된다. 또한, 표시 영역(DA)에는 데이터 라인들과 게이트 라인들의 교차 영역에 매트릭스 형태로 화상을 표시하는 화소(P)들이 형성된다. 화소(P)들 각각은 게이트 라인의 게이트 신호가 입력되면 데이터 라인의 데이터 전압에 따라 발광소자에 소정의

전류를 공급한다. 이로 인해, 화소(P)들 각각의 발광소자는 소정의 전류에 따라 소정의 밝기로 발광할 수 있다. 또한, 전원 라인에는 전원 전압이 공급된다. 전원 라인은 화소(P)들 각각에 전원 전압을 공급한다.

[0044] 이하에서는 도 4를 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 표시 영역(DA)의 화소(P)의 구조를 상세히 살펴본다.

[0045] 도 4는 도 3의 표시 영역의 화소의 일 예를 보여주는 단면도이다.

[0046] 도 4를 참조하면, 제1 기판(111)의 일면 상에는 박막 트랜지스터(210)들 및 커패시터(220)들이 형성된다.

[0047] 투습에 취약한 제1 기판(111)을 통해 침투하는 수분으로부터 박막 트랜지스터(210)들을 보호하기 위해 제1 기판(111) 상에는 벼파막(미도시)이 형성될 수 있다.

[0048] 박막 트랜지스터(210)들 각각은 액티브층(211), 게이트 전극(212), 소스 전극(213) 및 드레인 전극(214)을 포함한다. 도 4에서는 박막 트랜지스터(210)들의 게이트 전극(212)이 액티브층(211)의 상부에 위치하는 상부 게이트(탑 게이트, top gate) 방식으로 형성된 것을 예시하였으나, 이에 한정되지 않음에 주의하여야 한다. 즉, 박막 트랜지스터(210)들은 게이트 전극(212)이 액티브층(211)의 하부에 위치하는 하부 게이트(보텀 게이트, bottom gate) 방식 또는 게이트 전극(212)이 액티브층(211)의 상부와 하부에 모두 위치하는 더블 게이트(double gate) 방식으로 형성될 수 있다.

[0049] 제1 기판(111)의 벼파막 상에는 액티브층(211)이 형성된다. 액티브층(211)은 실리콘계 반도체 물질 또는 산화물계 반도체 물질로 형성될 수 있다. 제1 기판(111) 상에는 액티브층(211)으로 입사되는 외부광을 차단하기 위한 차광층이 형성될 수 있다.

[0050] 액티브층(211) 상에는 게이트 절연막(230)이 형성될 수 있다. 게이트 절연막(230)은 무기막, 예를 들어 실리콘 산화막, 실리콘 질화막 또는 이들의 다중막으로 형성될 수 있다.

[0051] 게이트 절연막(230) 상에는 게이트 전극(212)이 형성될 수 있다. 게이트 전극(212)은 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 금(Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu) 중 어느 하나 또는 이들의 합금으로 이루어진 단일층 또는 다중층일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

[0052] 게이트 전극(212) 상에는 충간 절연막(240)이 형성될 수 있다. 충간 절연막(240)은 무기막, 예를 들어 실리콘 산화막, 실리콘 질화막 또는 이들의 다중막으로 형성될 수 있다.

[0053] 충간 절연막(240) 상에는 소스 전극(213)과 드레인 전극(214)이 형성될 수 있다. 소스 전극(213)과 드레인 전극(214) 각각은 게이트 절연막(230)과 충간 절연막(240)을 관통하는 콘택홀(CH1, CH2)을 통해 액티브층(211)에 접속될 수 있다. 소스 전극(213)과 드레인 전극(214) 각각은 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 금(Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu) 중 어느 하나 또는 이들의 합금으로 이루어진 단일층 또는 다중층일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

[0054] 커패시터(220)들 각각은 하부 전극(221)과 상부 전극(222)을 포함한다. 하부 전극(221)은 게이트 절연막(230) 상에 형성되며, 게이트 전극(212)과 동일한 물질로 형성될 수 있다. 상부 전극(222)은 충간 절연막(240) 상에 형성되며, 소스 전극(223) 및 드레인 전극(224)과 동일한 물질로 형성될 수 있다.

[0055] 박막 트랜지스터(210) 및 커패시터(220) 상에는 보호막(미도시)이 형성될 수 있다. 보호막은 절연막으로서 역할을 할 수 있다. 보호막은 무기막, 예를 들어 실리콘 산화막, 실리콘 질화막 또는 이들의 다중막으로 형성될 수 있다. 보호막은 생략될 수 있다.

[0056] 보호막 상에는 박막 트랜지스터(210)와 커패시터(220)로 인한 단차를 평탄하게 하기 위한 평탄화막(250)이 형성될 수 있다. 평탄화막(250)은 아크릴 수지(acrylic resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 페놀 수지(phenolic resin), 폴리아미드 수지(polyamide resin), 폴리이미드 수지(polyimide resin) 등의 유기막으로 형성될 수 있다.

[0057] 평탄화막(250) 상에는 유기발광소자(270), 뱅크(260) 및 스페이서(265)가 형성된다. 유기발광소자(270)는 제2 전극(273), 유기발광층(272), 및 제1 전극(271)을 포함한다. 제2 전극(273)은 캐소드 전극이고, 제1 전극(271)은 애노드 전극일 수 있다. 제2 전극(273), 유기발광층(272) 및 제1 전극(271)이 적층된 영역은 발광부(EA)로 정의될 수 있다.

[0058] 제1 전극(271)은 평탄화막(250) 상에 형성될 수 있다. 제1 전극(271)은 보호막과 평탄화막(250)을 관통하는 콘택홀(CH3)을 통해 박막 트랜지스터(210)의 드레인 전극(214)에 접속된다. 제1 전극(271)은 알루미늄과 티타늄의

적층 구조(Ti/Al/Ti), 알루미늄과 ITO의 적층 구조(ITO/Al/ITO), APC 합금, 및 APC 합금과 ITO의 적층 구조(ITO/APC/ITO)과 같은 반사율이 높은 금속물질로 형성될 수 있다. APC 합금은 은(Ag), 팔라듐(Pd), 및 구리(Cu)의 합금이다.

[0059] 뱅크(260)은 발광부들(EA)을 구획하기 위해 평탄화막(250) 상에서 제1 전극(271)의 가장자리를 덮도록 형성될 수 있다. 뱅크(260)는 아크릴 수지(acrylic resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 페놀 수지(phenolic resin), 폴리아미드 수지(polyamide resin), 폴리이미드 수지(polyimide resin) 등의 유기막으로 형성될 수 있다.

[0060] 스페이서(265)는 뱅크(260) 상에 형성될 수 있다. 스페이서(265)는 아크릴 수지(acrylic resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 페놀 수지(phenolic resin), 폴리아미드 수지(polyamide resin), 폴리이미드 수지(polyimide resin) 등의 유기막으로 형성될 수 있다. 스페이서(265)는 생략될 수 있다.

[0061] 제1 전극(271), 뱅크(260) 및 스페이서(265) 상에는 유기발광층(272)이 형성된다. 유기발광층(272)은 정공 수송층(hole transporting layer), 적어도 하나의 발광층(light emitting layer), 및 전자 수송층(electron transporting layer)을 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 전극(271)과 제2 전극(273)에 전압이 인가되면 정공과 전자가 각각 정공 수송층과 전자 수송층을 통해 발광층으로 이동하게 되며, 발광층에서 서로 결합하여 발광하게 된다.

[0062] 유기발광층(272)은 백색 광을 발광하는 백색 발광층으로 이루어질 수 있다. 이 경우, 제1 전극(271)과 뱅크(260)를 덮도록 형성될 수 있다. 이 경우, 제2 기판(112) 상에는 컬러필터(미도시)가 형성될 수 있다.

[0063] 또는, 유기발광층(272)은 적색 광을 발광하는 적색 발광층, 녹색 광을 발광하는 녹색 발광층, 또는 청색 광을 발광하는 청색 발광층으로 이루어질 수 있다. 이 경우, 유기발광층(272)은 제1 전극(271)에 대응되는 영역에 형성될 수 있으며, 제2 기판(112) 상에는 컬러필터가 형성되지 않을 수 있다.

[0064] 제2 전극(273)은 유기발광층(272) 상에 형성된다. 유기발광표시장치가 상부 발광(top emission) 구조로 형성되는 경우, 제2 전극(273)은 광을 투과시킬 수 있는 ITO, IZO와 같은 투명한 금속물질(TCO, Transparent Conductive Material), 또는 마그네슘(Mg), 은(Ag), 또는 마그네슘(Mg)과 은(Ag)의 합금과 같은 반투과 금속물질(Semi-transmissive Conductive Material)로 형성될 수 있다.

[0065] 유기발광소자(270) 상에는 캡핑층(capping layer, 280)이 형성된다. 캡핑층(280)은 제2 전극(273) 상에 형성되어 제1 전극(271), 유기발광층(272) 및 제2 전극(273)을 보호한다. 또한, 캡핑층(280)은 유기발광층(272)에서 발생된 광이 효율적으로 외부를 향해 방출될 수 있도록 한다. 캡핑층(280)은 무기 물질 및 유기 물질 중 적어도 하나 이상의 물질로 이루어진다. 캡핑층(280)은 무기막 또는 유기막으로 이루어지거나, 무기 입자가 함유된 유기막으로 이루어질 수 있다.

[0066] 캡핑층(280)은 무기막으로서, 산화 아연(zinc oxide), 산화 티타늄(titanium oxide), 산화 지르코늄(zirconium oxide), 산화 나이오븀(niobium oxide), 산화 탄탈(tantalum oxide), 산화 주석(tin oxide), 산화 니켈(nickel oxide), 질화 규소(silicon nitride), 질화 인듐(indium nitride) 및 질화갈륨(gallium nitride) 등 일 수 있다.

[0067] 또한, 캡핑층(280)은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), PEDOT), 4,4'-비스[N-(3-메틸페닐)-N-페닐-아미노]비페닐(TPD), 4,4',4'''-트리스[(3-메틸페닐)페닐-아미노]트리페닐아민(m-MTDA), 1,3,5-트리스[N,N-비스(2-메틸페닐)-아미노]-벤젠(o-MTDAB), 1,3,5-트리스[N,N-비스(3-메틸페닐)-아미노]-벤젠(m-MTDAB), 1,3,5-트리스[N,N-비스(4-메틸페닐)-아미노]-벤젠(p-MTDAB), 4,4'-비스[N,N-비스(3-메틸페닐)-아미노]-디페닐메탄(BPPM), 4,4'-디카르바졸릴-1,1'-비페닐(CBP), 4,4',4'''-트리스(N-카르바졸)트리페닐아민(TCTA), 2,2',2'''-(1,3,5-벤젤톨릴)트리스-[1-페닐-1H-벤조이미다졸](TPBI), 및 3-(4-비페닐)-4-페닐-5-t-부틸페닐-1,2,4-트리아졸(TAZ) 등 일 수 있다.

[0068] 캡핑층(280) 상에는 봉지막(290)이 형성된다. 봉지막(290)은 유기발광층(272)과 제2 전극(273)에 산소 또는 수분이 침투되는 것을 방지하는 역할을 한다. 이를 위해, 봉지막(290)은 적어도 하나의 무기막과 적어도 하나의 유기막을 포함할 수 있다.

[0069] 예를 들어, 봉지막(290)은 제1 무기막(291), 유기막(292), 및 제2 무기막(293)을 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 무기막(291)은 제2 전극(273)을 덮도록 형성된다. 유기막(292)은 제1 무기막(291) 상에 형성된다. 유기막(292)은 이물들(particles)이 제1 무기막(291)을 뚫고 유기발광층(272)과 제2 전극(273)에 투입되는 것을 방지하기 위해 충분한 두께로 형성되는 것이 바람직하다. 제2 무기막(293)은 유기막(292)을 덮도록 형성된다.

- [0070] 봉지막(290) 상에는 제1 내지 제3 컬러필터들(미도시)과 블랙 매트릭스(미도시)이 형성될 수 있다. 적색 발광부에는 적색 컬러필터가 형성되고, 청색 발광부에는 청색 컬러필터가 형성되며, 녹색 발광부에는 녹색 컬러필터가 형성될 수 있다.
- [0071] 제1 기판(111)의 봉지막(290)과 제2 기판(112)의 컬러필터들(미도시)은 접착층(미도시)을 이용하여 접착되며, 이로 인해 제1 기판(111)과 제2 기판(112)은 합착될 수 있다. 접착층은 투명한 접착 레진일 수 있다.
- [0072] 다시 도 3을 참조하면, 패드 영역(PA)은 제1 기판(111)의 일 측 가장자리에 배치될 수 있다. 패드 영역(PA)은 복수의 패드들을 포함하며, 복수의 패드들은 이방성 도전 필름(antisotropic conducting film)을 이용하여 연성 필름(150)의 배선들과 전기적으로 연결될 수 있다.
- [0073] 댐(120)은 비표시 영역(NDA)에서 표시 영역(DA)을 둘러싸도록 배치되어 봉지막(290)을 구성하는 유기막(292)이 외부로 노출되지 못하도록 유기막(292)의 흐름을 차단한다. 또한, 댐(120)은 표시 영역(DA)과 패드 영역(PA) 사이에 배치되어 화소(P)의 봉지막(290)을 구성하는 유기막(292)이 패드 영역(PA)을 침범하지 못하도록 유기막(292)의 흐름을 차단한다.
- [0074] 이하에서는 도 5를 함께 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 표시장치를 보다 상세히 살펴본다.
- [0075] 도 5는 도 3에 도시된 II-II' 선의 제1 실시예를 나타내는 단면도이다.
- [0076] 도 5는 설명의 편의를 위하여 박막 트랜지스터(210)들 및 커패시터(220)의 구체적인 구성을 생략하고 이들을 포함하는 TFT 기판(200)을 도시하고 있다. TFT 기판(200)은 제1 기판(111)에 박막 트랜지스터(210)들 및 커패시터(220)가 형성된 기판을 나타낸다.
- [0077] 도 5를 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 표시장치는 TFT 기판(200) 상에 형성된 유기발광소자(270), 캡핑층(280), 봉지막(290) 및 댐(120)을 포함한다. 이때, TFT 기판(200)은 화소(P)들이 형성된 표시 영역(DA) 및 표시 영역(DA)을 둘러싸는 비표시 영역(NDA)을 포함한다. 비표시 영역(NDA)은 복수의 패드들이 형성된 패드 영역(PA)을 포함한다.
- [0078] 유기발광소자(270)는 표시 영역(DA)에 배치된다. 유기발광소자(270)는 제2 전극(273), 유기발광층(272), 및 제1 전극(271)을 포함한다. 제2 전극(273)은 캐소드 전극이고, 제1 전극(271)은 애노드 전극일 수 있다. 제2 전극(273), 유기발광층(272) 및 제1 전극(271)이 적층된 영역은 발광부(EA)로 정의될 수 있다.
- [0079] 제1 전극(271)은 평탄화막(250) 상에 형성될 수 있다. 제1 전극(271)은 표시 영역(DA)으로부터 연장되어 비표시 영역(NDA)의 일부 영역까지 형성될 수 있다. 제1 전극(271)은 도 5와 같이 비표시 영역(NDA)에 배치된 댐(120)까지 연장될 수 있다. 제1 전극(271)은 화소(P)가 배치된 표시 영역(DA)에서 보호막과 평탄화막(250)을 관통하는 콘택홀(CH3)을 통해 박막 트랜지스터(210)의 소스 전극(213) 또는 드레인 전극(214)에 접속된다.
- [0080] 유기발광층(272)은 제1 전극(271) 상에 형성된다. 유기발광층(272)은 정공 수송층(hole transporting layer), 적어도 하나의 발광층(light emitting layer), 및 전자 수송층(electron transporting layer)을 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 전극(271)과 제2 전극(273)에 전압이 인가되면 정공과 전자가 각각 정공 수송층과 전자 수송층을 통해 발광층으로 이동하게 되며, 발광층에서 서로 결합하여 발광하게 된다.
- [0081] 제2 전극(273)은 유기발광층(272) 상에 형성된다. 제2 전극(273)은 표시 영역(DA)보다 넓은 면적을 가지도록 형성된다. 제2 전극(273)은 표시 영역(DA)으로부터 연장되어 비표시 영역(NDA)의 일부 영역까지 형성될 수 있다. 다만, 제2 전극(273)은 댐(120)이 형성된 영역 안쪽으로 형성되며, 댐(120)과 이격 배치된다.
- [0082] 캡핑층(280)은 제2 전극(273) 상에 형성된다. 캡핑층(280)은 무기 물질 및 유기 물질 중 적어도 하나 이상의 물질로 이루어진다. 캡핑층(280)은 무기막 또는 유기막으로 이루어지거나, 무기 입자가 함유된 유기막으로 이루어질 수 있다.
- [0083] 캡핑층(280)은 도 5와 같이 제2 전극(273)과 동일한 크기로 형성되어, 제1 전극(271), 유기발광층(272) 및 제2 전극(273)을 보호한다. 도 5에서는 캡핑층(280)이 제2 전극(273)과 동일한 크기로 형성되는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다른 일 실시예에 있어서, 캡핑층(280)은 제2 전극(273)보다 작은 크기로 형성될 수 있다. 캡핑층(280)은 유기발광층(272)에서 발생된 광이 효율적으로 외부를 향해 방출될 수 있도록 하기 위하여 표시 영역(DA)에는 형성되어야 하며, 비표시 영역(NDA)에는 반드시 형성될 필요는 없다.
- [0084] 한편, 본 발명의 제1 실시예에 따른 표시장치는 박막 트랜지스터(210) 및 커패시터(220) 상에 형성되는 보호막이 생략될 수 있다. 이와 같은 경우, 비표시 영역(NDA)에 형성된 전원 라인(310) 상에는 봉지막(290)을 구성하

는 제1 무기막(291) 또는 제2 무기막(293)이 직접 형성하게 된다. 이때, 제1 무기막(291) 또는 제2 무기막(293)은 전원 라인(310)에 의하여 발생한 단차로 인하여 무기막이 끊어지는 심(seam)이 발생할 수 있으며, 심(seam)을 통해 수분이 침투할 수 있다. 이를 방지하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 표시장치는 유기보호막(320)을 추가 형성할 수 있다.

[0085] 유기보호막(320)은 비표시 영역(NDA)에서 댐(120)과 이격 배치되어, 전원 라인(310)의 가장자리를 덮도록 형성될 수 있다. 즉, 전원 라인(310)은 일단이 평탄화막(250)에 의하여 덮이고, 다른 일단이 유기보호막(320)에 의하여 덮일 수 있다.

[0086] 이러한 유기보호막(320)은 화소(P)의 평탄화막(250), 뱅크(260) 및 스페이서(265) 중 적어도 하나와 동시에 형성될 수 있으며, 평탄화막(250), 뱅크(260) 및 스페이서(265) 중 적어도 하나와 같은 물질로 이루어질 수 있다. 예컨대, 유기보호막(320)은 뱅크(260)와 동일 물질로 동시에 형성될 수 있다. 이와 같은 경우, 유기보호막(320)은 아크릴 수지(acryl resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 페놀 수지(phenolic resin), 폴리아미드 수지(polyamide resin), 폴리아이미드 수지(polyimide resin) 등의 유기 물질로 형성될 수 있다.

[0087] 봉지막(290)은 표시 영역(DA)에 형성된 유기발광소자(270) 및 캡핑층(280)을 덮도록 형성되어 유기발광소자(270)에 산소 또는 수분이 침투되는 것을 방지한다. 이때, 봉지막(290)은 적어도 하나의 무기막 및 적어도 하나의 유기막을 포함한다. 예를 들어, 봉지막(290)은 제1 무기막(291), 유기막(292), 및 제2 무기막(293)을 포함할 수 있다.

[0088] 제1 무기막(291)은 유기발광소자(270), 캡핑층(280) 및 댐(120) 상에 패턴 형성될 수 있다. 구체적으로, 제1 무기막(291)은 제1 패턴(291a), 제2 패턴(291b) 및 제3 패턴(291c)을 포함할 수 있다. 제1 무기막(291)의 제1 패턴(291a)은 유기발광소자(270) 및 캡핑층(280)을 덮도록 형성되고, 제1 댐(121)과 이격 배치된다. 제1 무기막(291)의 제2 패턴(291b)은 제1 댐(121)을 덮도록 형성되고, 제1 패턴(291a) 및 제3 패턴(291c)과 이격 배치된다. 제1 무기막(291)의 제3 패턴(291c)은 제2 댐(122)을 덮도록 형성되고, 제2 패턴(291b)과 이격 배치된다.

[0089] 또한, 제2 댐(122)과 이격하여 유기보호막(320)이 형성된 경우, 제1 무기막(291)은 제4 패턴(291d)을 더 포함할 수 있다. 제1 무기막(291)의 제4 패턴(291d)은 유기보호막(320)을 덮도록 형성되고, 제3 패턴(291c)과 이격 배치될 수 있다.

[0090] 제1 무기막(291)은 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)과 접촉하여 형성된다. 이때, 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)은 유기물질로 이루어진다. 유기물질로 이루어진 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)과 제1 무기막(291) 간의 계면 접착력이 약하므로, 계면 들뜸이 발생할 수 있다. 이와 같은 경우, 제1 무기막(291)과 댐(120) 사이의 계면으로 수분이 침투할 가능성이 높다.

[0091] 수분이 확산되는 것을 방지하기 위하여, 본 발명의 제1 실시예에 따른 표시장치는 상술한 바와 같이 제1 무기막(291)이 패턴 형성되는 것을 특징으로 한다. 특히, 본 발명의 제1 실시예에 따른 표시장치는 제2 댐(122) 상에 직접 형성되는 제1 무기막(291)이 제3 패턴(291c)으로 패턴 형성되어 제2 패턴(291b)과 이격 배치됨으로써, 제1 무기막(291)의 제3 패턴(291c)으로 침투한 수분이 제2 패턴(291b)으로 확산되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 본 발명의 제1 실시예에 따른 표시장치는 제1 댐(121) 상에 직접 형성되는 제1 무기막(291)이 제2 패턴(291b)으로 패턴 형성되어 제1 패턴(291a)과 이격 배치됨으로써, 제1 무기막(291)의 제2 패턴(291b)으로 침투한 수분이 제1 패턴(291a)으로 확산되는 것을 방지할 수 있다.

[0092] 도 5에서는 제1 무기막(291)이 제1 패턴(291a), 제2 패턴(291b) 및 제3 패턴(291c)을 포함하는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않는다. 제1 무기막(291)은 가장 외곽에 배치된 제2 댐(122) 상에서 패턴 형성되며 된다. 이에 따라, 제1 무기막(291)은 제2 패턴(291b)이 생략되거나, 제1 패턴(291a)이 유기발광소자(270) 및 캡핑층(280)은 물론 제1 댐(121)까지 덮도록 형성될 수 있다. 이와 같은 경우에도 제1 패턴(291a)과 제3 패턴(291c)은 이격 배치되어야 한다.

[0093] 유기막(292)은 제1 무기막(291) 상에 형성된다. 유기막(292)은 제1 댐(121)에 의하여 흐름이 차단되므로, 제1 댐(121) 안쪽으로 형성된다. 제2 무기막(293)은 유기막(292) 및 댐(120)을 덮도록 형성된다. 이때, 제2 무기막(293)은 제1 무기막(291)과 달리 하나의 패턴으로 유기막(292) 및 댐(120)을 덮도록 형성되어, 유기막(292)으로 수분이 침투하는 것을 차단할 수 있다. 제2 댐(122)과 이격하여 유기보호막(320)이 형성된 경우, 제2 무기막(293)은 유기막(292) 및 댐(120)은 물론 유기보호막(320)까지 덮도록 형성될 수 있다.

[0094] 제1 및 제2 무기막들(291, 293) 각각은 실리콘 질화물, 알루미늄 질화물, 지르코늄 질화물, 티타늄 질화물, 하프늄 질화물, 탄탈륨 질화물, 실리콘 산화물, 알루미늄 산화물 또는 티타늄 산화물로 형성될 수 있다. 제1 및

제2 무기막들(291, 293)은 CVD(Chemical Vapor Deposition) 기법 또는 ALD(Atomic Layer Deposition) 기법으로 증착될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0095] 유기막(292)은 유기발광층(272)에서 발광된 광을 통과시키기 위해 투명하게 형성될 수 있다. 유기막(292)은 유기발광층(272)에서 발광된 광을 99% 이상 통과시킬 수 있는 유기물질 예컨대, 아크릴 수지(acryl resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 폐놀 수지(phenolic resin), 폴리아미드 수지(polyamide resin) 또는 폴리이미드 수지(polyimide resin)로 형성될 수 있다. 유기막(292)은 유기물을 사용하는 기상 증착(vapour deposition), 프린팅(printing), 슬릿 코팅(slit coating) 기법으로 형성될 수 있으나, 이에 제한되지 않으며, 유기막(292)는 잉크젯(ink-jet) 공정으로 형성될 수도 있다.

[0096] 댐(120)은 비표시 영역(NDA)에서 제2 전극(273) 및 캡핑층(280)과 이격하여 배치된다. 댐(120)은 표시 영역(DA)의 외곽을 둘러싸도록 형성되어 봉지막(290)을 구성하는 유기막(292)의 흐름을 차단한다. 댐(120)은 표시 영역(DA)과 패드 영역(PA) 사이에 배치되어 봉지막(290)을 구성하는 유기막(292)이 패드 영역(PA)을 침범하지 못하도록 유기막(292)의 흐름을 차단한다. 이를 통해, 댐(120)은 유기막(292)이 표시장치의 외부로 노출되거나 유기막(292)이 패드 영역(PA)을 침범하는 것을 방지할 수 있다.

[0097] 이러한 댐(120)은 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)을 포함할 수 있다. 제1 댐(121)은 표시 영역(DA)의 외곽을 둘러싸도록 형성되어 봉지막(290)을 구성하는 유기막(292)의 흐름을 1차적으로 차단할 수 있다. 또한, 제1 댐(121)은 표시 영역(DA)과 패드 영역(PA) 사이에 배치되어 봉지막(290)을 구성하는 유기막(292)이 패드 영역(PA)을 침범하지 못하도록 유기막(292)의 흐름을 1차적으로 차단할 수 있다.

[0098] 제1 댐(121)은 유기막(292)이 TFT 기판(200) 상에 형성된 유기발광소자(280)를 충분히 덮을 수 있도록 유기발광소자(280)가 형성된 영역과 이격하여 형성되는 것이 바람직하다. 또한, 제1 댐(121)은 외부 환경에 취약한 유기물질로 이루어진 평탄화막(250) 및 맹크(260)와 같은 구조와 이격하여 형성되는 것이 바람직하다.

[0099] 이러한 제1 댐(121)은 도 5와 같이 화소(P)들 각각에 전원 전압을 공급하는 전원 라인(310) 또는 표시 영역(DA)으로부터 연장되어 전원 라인(310)과 접촉하는 제1 전극(271) 상에 형성될 수 있다. 제1 댐(121)은 제1 하부층(121a)을 포함할 수 있다. 제1 하부층(121a)은 전원 라인(310) 또는 제1 전극(271) 상에 형성될 수 있다.

[0100] 제1 댐(121)의 제1 하부층(121a)은 화소(P)의 평탄화막(250), 맹크(260) 및 스페이서(265) 중 적어도 하나와 동시에 형성될 수 있으며, 평탄화막(250), 맹크(260) 및 스페이서(265) 중 적어도 하나와 같은 물질로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 제1 댐(121)의 제1 하부층(121a)은 평탄화막(250)과 동일 물질로 동시에 형성될 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 댐(121)의 제1 하부층(121a)은 맹크(260)와 동일 물질로 동시에 형성될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제1 댐(121)의 제1 하부층(121a)은 스페이서(265)와 동일 물질로 동시에 형성될 수 있다. 이와 같은 경우, 제1 댐(121)의 제1 하부층(121a)은 아크릴 수지(acryl resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 폐놀 수지(phenolic resin), 폴리아미드 수지(polyamide resin), 폴리이미드 수지(polyimide resin) 등의 유기 물질로 형성될 수 있다.

[0101] 도 5에서는 제1 댐(121)이 제1 하부층(121a)을 포함하는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 다른 실시예에 있어서, 제1 댐(121)은 하부층 및 상부층으로 2층 구조로 형성될 수도 있다. 또 다른 실시예에 있어서, 제1 댐(121)은 하부층, 중간층 및 상부층으로 3층 구조로 형성될 수도 있다.

[0102] 제2 댐(122)은 제1 댐(121)의 외곽에 형성되어 제1 댐(121)의 외곽으로 훌러 넘치는 유기막(292)을 2차적으로 차단할 수 있다. 이를 통해, 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)은 유기막(292)이 표시장치의 외부로 노출되거나 패드 영역(PA)을 침범하는 것을 보다 효과적으로 차단할 수 있다.

[0103] 이러한 제2 댐(122)은 도 5와 같이 화소(P)들 각각에 전원 전압을 공급하는 전원 라인(310) 상에 형성될 수 있다. 제2 댐(122)은 제2 하부층(122a) 및 제2 상부층(122b)을 포함할 수 있다. 제2 하부층(122a)은 전원 라인(310) 상에 형성될 수 있고, 제2 상부층(122b)은 제2 하부층(122a) 상에 형성될 수 있다.

[0104] 제2 댐(122)의 제2 하부층(122a) 및 제2 상부층(122b)은 화소(P)의 평탄화막(250), 맹크(260) 및 스페이서(265) 중 적어도 하나와 동시에 형성될 수 있으며, 평탄화막(250), 맹크(260) 및 스페이서(265) 중 적어도 하나와 같은 물질로 이루어질 수 있다. 예컨대, 제2 댐(122)의 제2 하부층(122a)은 평탄화막(250)과 동일 물질로 동시에 형성될 수 있다. 이와 같은 경우, 제2 댐(122)의 제2 상부층(122b)은 맹크(260)와 동일 물질로 동시에 형성될 수 있다. 이와 같은 경우, 제2 댐(122)의 제2 하부층(122a) 및 제2 상부층(122b)은 아크릴 수지(acryl resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 폐놀 수지(phenolic resin), 폴리아미드 수지(polyamide resin), 폴리이미드 수지(polyimide

resin) 등의 유기 물질로 형성될 수 있다.

[0105] 도 5에서는 제2 댐(122)이 제2 하부층(122a) 및 제2 상부층(122b)을 포함하는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 다른 실시예에 있어서, 제2 댐(122)은 하부층으로 단층 구조로 형성될 수도 있다. 또 다른 실시예에 있어서, 제2 댐(122)은 하부층, 중간층 및 상부층으로 3층 구조로 형성될 수도 있다.

[0106] 도 5에서는 댐(120)이 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)을 포함하는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다른 일 실시예에 있어서, 댐(120)은 제1 댐(121)만을 포함할 수도 있다.

제2 실시예

[0109] 도 6은 도 3에 도시된 II-II' 선의 제2 실시예를 나타내는 단면도이고, 도 7은 도 6의 변형된 실시예를 나타내는 도면이다.

[0110] 도 6을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 표시장치는 TFT 기판(200) 상에 형성된 유기발광소자(270), 캡핑층(280), 봉지막(290) 및 댐(120)을 포함하고, 유기보호막(320)을 더 포함할 수 있다. 유기발광소자(270), 댐(120) 및 유기보호막(320)은 도 5에 도시된 구성과 실질적으로 동일하므로 구체적인 설명은 생략하도록 한다. 이하에서는 도 5에 도시된 구성과 차이가 있는 구성을 중점적으로 설명하도록 한다.

[0111] 도 6을 참조하면, TFT 기판(200)은 화소(P)들이 형성된 표시 영역(DA) 및 표시 영역(DA)을 둘러싸는 비표시 영역(NDA)를 포함한다. 비표시 영역(NDA)은 복수의 패드들이 형성된 패드 영역(PA)을 포함한다.

[0112] 캡핑층(280)은 제2 전극(273) 상에 형성된다. 본 발명의 제2 실시예에 따른 캡핑층(280)은 무기 물질로 이루어지며, 제1 패턴(280a), 제2 패턴(280b) 및 제3 패턴(280c)을 포함할 수 있다. 캡핑층(280)의 제1 패턴(280a)은 유기발광소자(270) 상에 형성되고, 제1 댐(121)과 이격 배치된다. 이때, 캡핑층(280)의 제1 패턴(280a)은 도 6과 같이 제2 전극(273)과 동일한 크기로 형성되어, 제1 전극(271), 유기발광층(272) 및 제2 전극(273)을 보호할 수 있다. 도 6에서는 캡핑층(280)의 제1 패턴(280a)이 제2 전극(273)과 동일한 크기로 형성되는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다른 일 실시예에 있어서, 캡핑층(280)의 제1 패턴(280a)은 제2 전극(273)보다 작은 크기로 형성될 수 있다. 캡핑층(280)의 제1 패턴(280a)은 유기발광층(272)에서 발생된 광이 효율적으로 외부를 향해 방출될 수 있도록 하기 위하여 표시 영역(DA)에는 형성되어야 하며, 비표시 영역(NDA)에는 반드시 형성될 필요는 없다.

[0113] 캡핑층(280)의 제2 패턴(280b)은 제1 댐(121)을 덮도록 형성되고, 제1 패턴(280a) 및 제3 패턴(280c)과 이격 배치된다. 캡핑층(280)의 제3 패턴(280c)은 제2 댐(122)을 덮도록 형성되고, 제2 패턴(280b)과 이격 배치된다.

[0114] 또한, 제2 댐(122)과 이격하여 유기보호막(320)이 형성된 경우, 캡핑층(280)은 제4 패턴(280d)을 더 포함할 수 있다. 캡핑층(280)의 제4 패턴(280d)은 유기보호막(320)을 덮도록 형성되고, 제3 패턴(280c)과 이격 배치될 수 있다.

[0115] 종래의 표시장치는 봉지막(290)을 구성하는 제1 무기막(291)이 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)과 접촉하여 형성된다. 이때, 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)은 유기물질로 이루어지는데, 유기물질로 이루어진 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)과 제1 무기막(291) 간의 계면 접착력이 약하기 때문에, 계면 들뜸이 발생할 수 있다. 이와 같은 경우, 제1 무기막(291)과 댐(120) 사이의 계면으로 수분이 침투할 가능성이 높다.

[0116] 수분이 확산되는 것을 방지하기 위하여, 본 발명의 제2 실시예에 따른 표시장치는 제1 댐(121)과 제1 무기막(291) 사이에 캡핑층(280)의 제2 패턴(280b)을 형성하고, 제2 댐(122)과 제1 무기막(291) 사이에 캡핑층(280)의 제3 패턴(280c)을 형성하는 것을 특징으로 한다.

[0117] 구체적으로, 본 발명의 제2 실시예에 따른 표시장치는 제2 댐(122)과 제1 무기막(291) 사이에 캡핑층(280)을 형성한다. 그리고 본 발명의 제2 실시예에 따른 표시장치는 제2 댐(122) 상에 직접 형성되는 캡핑층(280)이 제3 패턴(280c)으로 패턴 형성되어 제2 패턴(280b)과 이격 배치됨으로써, 캡핑층(280)의 제3 패턴(280c)으로 침투한 수분이 제2 패턴(280b)으로 확산되는 것을 방지할 수 있다.

[0118] 또한, 본 발명의 제2 실시예에 따른 표시장치는 제1 댐(121)과 제1 무기막(291) 사이에 캡핑층(280)을 형성한다. 그리고 본 발명의 제2 실시예에 따른 표시장치는 제1 댐(121) 상에 직접 형성되는 캡핑층(280)이 제2 패턴(280b)으로 패턴 형성되어 제1 패턴(280a)과 이격 배치됨으로써, 캡핑층(280)의 제2 패턴(280b)으로 침투한 수분이 제1 패턴(280c)으로 확산되는 것을 방지할 수 있다.

- [0119] 도 6에서는 캡핑층(280)이 제1 패턴(280a), 제2 패턴(280b) 및 제3 패턴(280c)을 포함하는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않는다. 캡핑층(280)은 가장 외곽에 배치된 제2 댐(122) 상에서 패턴 형성되면 된다. 이에 따라, 캡핑층(280)은 제2 패턴(280b)이 생략되거나, 제1 패턴(280a)이 유기발광소자(270)은 물론 제1 댐(121)까지 덮도록 형성될 수 있다. 이와 같은 경우에도 제1 패턴(280a)과 제3 패턴(280c)은 이격 배치되어야 한다.
- [0120] 캡핑층(280)은 무기막으로서, 산화 아연(zinc oxide), 산화 티타늄(titanium oxide), 산화 지르코늄(zirconium oxide), 산화 나이오븀(niobium oxide), 산화 탄탈(tantalum oxide), 산화 주석(tin oxide), 산화 니켈(nickel oxide), 질화 규소(silicon nitride), 질화 인듐(indium nitride) 또는 질화갈륨(gallium nitride)으로 이루어질 수 있다. 이와 같은 물질로 이루어진 캡핑층(280)은 봉지막(290)을 구성하는 제1 무기막(291) 보다 유기물질 간의 계면 접착력이 높게 나타난다.
- [0121] 본 발명의 제2 실시예에 따른 표시장치는 제2 댐(122)과 제1 무기막(291) 사이에 캡핑층(280)을 형성함으로써, 제2 댐(122)에서의 계면 접착력을 향상시킬 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 제2 실시예에 따른 표시장치는 제2 댐(122)에서의 계면 들뜸을 방지할 수 있다.
- [0122] 한편, 도 6에서는 캡핑층(280)이 무기막으로서 하나의 층으로 이루어진 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다른 일 실시예에 있어서, 표시장치는 도 7에 도시된 바와 같이 제1 캡핑층(280) 및 제2 캡핑층(285)를 포함할 수도 있다. 제1 캡핑층(280)은 무기막으로서 도 6에 도시된 캡핑층(280)과 실질적으로 동일하다. 제2 캡핑층(285)은 유기막일 수 있다. 제2 캡핑층(285)은 유기막이므로, 무기막인 제1 캡핑층(280)에 의하여 덮여지는 것이 바람직하다. 이러한 제2 캡핑층(285)은 제1 댐(121) 및 제2 댐(122) 상에는 형성되지 않으며, 제2 전극(273) 상에만 형성될 수 있다.
- [0123] 봉지막(290)은 표시 영역(DA)에 형성된 유기발광소자(270) 및 캡핑층(280)을 덮도록 형성되어 유기발광소자(270)에 산소 또는 수분이 침투되는 것을 방지한다. 이때, 봉지막(290)은 적어도 하나의 무기막 및 적어도 하나의 유기막을 포함한다. 예를 들어, 봉지막(290)은 제1 무기막(291), 유기막(292), 및 제2 무기막(293)을 포함할 수 있다.
- [0124] 제1 무기막(291)은 유기발광소자(270), 캡핑층(280) 및 댐(120)을 덮도록 형성될 수 있다. 제2 댐(122)과 이격하여 유기보호막(320)이 형성된 경우, 제1 무기막(291)은 유기발광소자(270), 캡핑층(280) 및 댐(120)은 물론 유기보호막(320)까지 덮도록 형성될 수 있다.
- [0125] 유기막(292)은 제1 무기막(291) 상에 형성된다. 유기막(292)은 제1 댐(121)에 의하여 흐름이 차단되므로, 제1 댐(121) 안쪽으로 형성된다. 제2 무기막(293)은 유기막(292) 및 댐(120)을 덮도록 형성된다. 제2 댐(122)과 이격하여 유기보호막(320)이 형성된 경우, 제2 무기막(293)은 유기막(292) 및 댐(120)은 물론 유기보호막(320)까지 덮도록 형성될 수 있다.
- [0126] 제1 및 제2 무기막들(291, 293) 각각은 실리콘 질화물, 알루미늄 질화물, 지르코늄 질화물, 티타늄 질화물, 하프늄 질화물, 탄탈륨 질화물, 실리콘 산화물, 알루미늄 산화물 또는 티타늄 산화물로 형성될 수 있다. 제1 및 제2 무기막들(291, 293)은 CVD(Chemical Vapor Deposition) 기법 또는 ALD(Atomic Layer Deposition) 기법으로 증착될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0127] 유기막(292)은 유기발광층(272)에서 발광된 광을 통과시키기 위해 투명하게 형성될 수 있다. 유기막(292)은 유기발광층(272)에서 발광된 광을 99% 이상 통과시킬 수 있는 유기물질 예컨대, 아크릴 수지(acrylic resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 폐놀 수지(phenolic resin), 폴리아미드 수지(polyamide resin) 또는 폴리이미드 수지(polyimide resin)로 형성될 수 있다. 유기막(292)은 유기물을 사용하는 기상 증착(vapour deposition), 프린팅(printing), 슬릿 코팅(slit coating) 기법으로 형성될 수 있으나, 이에 제한되지 않으며, 유기막(292)은 잉크젯(ink-jet) 공정으로 형성될 수도 있다.
- [0128] 도 6에서는 댐(120)이 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)을 포함하는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다른 일 실시예에 있어서, 댐(120)은 제1 댐(121)만을 포함할 수도 있다.
- [0130] 제3 실시예
- [0131] 도 8은 도 3에 도시된 II-II' 선의 제3 실시예를 나타내는 단면도이다.
- [0132] 도 8을 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 표시장치는 TFT 기판(200) 상에 형성된 유기발광소자(270), 캡

평층(280), 봉지막(290) 및 댐(120)을 포함하고, 유기보호막(320)을 더 포함할 수 있다. 댐(120), 봉지막(290) 및 유기보호막(320)은 도 6에 도시된 구성과 실질적으로 동일하므로 구체적인 설명은 생략하도록 한다. 이하에서는 도 6에 도시된 구성과 차이가 있는 구성을 중점적으로 설명하도록 한다.

[0133] 도 8을 참조하면, TFT 기판(200)은 화소(P)들이 형성된 표시 영역(DA) 및 표시 영역(DA)을 둘러싸는 비표시 영역(NDA)를 포함한다. 비표시 영역(NDA)은 복수의 패드들이 형성된 패드 영역(PA)을 포함한다.

[0134] 유기발광소자(270)는 표시 영역(DA)에 배치된다. 유기발광소자(270)는 제2 전극(273), 유기발광층(272), 및 제1 전극(271)을 포함한다. 제2 전극(273)은 캐소드 전극이고, 제1 전극(271)은 애노드 전극일 수 있다. 제2 전극(273), 유기발광층(272) 및 제1 전극(271)이 적층된 영역은 발광부(EA)로 정의될 수 있다.

[0135] 제2 전극(273)은 유기발광층(272) 상에 형성된다. 본 발명의 제3 실시예에 따른 제2 전극(273)은 제1 패턴(273a), 제2 패턴(273b) 및 제3 패턴(273c)을 포함할 수 있다. 제2 전극(273)의 제1 패턴(273a)은 유기발광층(272), 뱅크(260) 및 스페이서(265) 상에 형성되고, 제1 댐(121)과 이격 배치된다. 제2 전극(273)의 제2 패턴(273b)은 제1 댐(121)을 덮도록 형성되고, 제1 패턴(273a) 및 제3 패턴(273c)과 이격 배치된다. 제2 전극(273)의 제3 패턴(273c)은 제2 댐(122)을 덮도록 형성되고, 제2 패턴(273b)과 이격 배치된다.

[0136] 또한, 제2 댐(122)과 이격하여 유기보호막(320)이 형성된 경우, 제2 전극(273)은 제4 패턴(273d)을 더 포함할 수 있다. 제2 전극(273)의 제4 패턴(273d)은 유기보호막(320)을 덮도록 형성되고, 제3 패턴(273c)과 이격 배치될 수 있다.

[0137] 캡핑층(280)은 제2 전극(273) 상에 형성된다. 본 발명의 제3 실시예에 따른 캡핑층(280)은 무기 물질로 이루어지며, 제1 패턴(280a), 제2 패턴(280b) 및 제3 패턴(280c)을 포함할 수 있다. 캡핑층(280)의 제1 패턴(280a)은 유기발광소자(270) 상에 형성되고, 제1 댐(121)과 이격 배치된다. 캡핑층(280)의 제2 패턴(280b)은 제1 댐(121)을 덮도록 형성되고, 제1 패턴(280a) 및 제3 패턴(280c)과 이격 배치된다. 캡핑층(280)의 제3 패턴(280c)은 제2 댐(122)을 덮도록 형성되고, 제2 패턴(280b)과 이격 배치된다.

[0138] 또한, 제2 댐(122)과 이격하여 유기보호막(320)이 형성된 경우, 캡핑층(280)은 제4 패턴(280d)을 더 포함할 수 있다. 캡핑층(280)의 제4 패턴(280d)은 유기보호막(320)을 덮도록 형성되고, 제3 패턴(280c)과 이격 배치될 수 있다.

[0139] 본 발명의 제3 실시예에 따른 표시장치는 도 8과 같이 캡핑층(280)이 제2 전극(273)과 중첩되어 동일한 형성 면적을 가지도록 형성될 수 있다. 이와 같은 경우, 하나의 마스크를 이용하여 캡핑층(280) 및 제2 전극(273)을 형성할 수 있다. 즉, 제조 비용을 절감할 수 있다.

[0140] 한편, 종래의 표시장치는 봉지막(290)을 구성하는 제1 무기막(291)이 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)과 접촉하여 형성된다. 이때, 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)은 유기물질로 이루어지는데, 유기물질로 이루어진 제1 댐(121) 및 제2 댐(122)과 제1 무기막(291) 간의 계면 접착력이 약하기 때문에, 계면 들뜸이 발생할 수 있다. 이와 같은 경우, 제1 무기막(291)과 댐(120) 사이의 계면으로 수분이 침투할 가능성이 높다.

[0141] 수분이 확산되는 것을 방지하기 위하여, 본 발명의 제3 실시예에 따른 표시장치는 제1 댐(121)과 제1 무기막(291) 사이에 제2 전극(273)의 제2 패턴(273b) 및 캡핑층(280)의 제2 패턴(280b)을 형성하고, 제2 댐(122)과 제1 무기막(291) 사이에 제2 전극(273)의 제3 패턴(273c) 및 캡핑층(280)의 제3 패턴(280c)을 형성하는 것을 특징으로 한다.

[0142] 구체적으로, 본 발명의 제3 실시예에 따른 표시장치는 제2 댐(122)과 제1 무기막(291) 사이에 제2 전극(273) 및 캡핑층(280)을 형성한다. 그리고 본 발명의 제3 실시예에 따른 표시장치는 제2 댐(122) 상에 직접 형성되는 제2 전극(273)이 제3 패턴(273c)으로 형성되어 제2 패턴(273b)과 이격 배치됨으로써, 제2 전극(273)의 제3 패턴(273c)으로 침투한 수분이 제2 패턴(273b)으로 확산되는 것을 방지할 수 있다.

[0143] 또한, 본 발명의 제3 실시예에 따른 표시장치는 제1 댐(121)과 제1 무기막(291) 사이에 제2 전극(273) 및 캡핑층(280)을 형성한다. 그리고 본 발명의 제3 실시예에 따른 표시장치는 제1 댐(121) 상에 직접 형성되는 제2 전극(273)의 제2 패턴(273b)으로 패턴 형성되어 제1 패턴(273a)과 이격 배치됨으로써, 제2 전극(273)의 제2 패턴(273b)으로 침투한 수분이 제1 패턴(273c)으로 확산되는 것을 방지할 수 있다.

[0144] 도 8에서는 제2 전극(273) 및 캡핑층(280)이 제1 패턴(273a, 280a), 제2 패턴(273b, 280b) 및 제3 패턴(273c, 280c)을 포함하는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않는다. 제2 전극(273) 및 캡핑층(280)은 가장 외곽에 배치된 제2 댐(122) 상에서 패턴 형성되면 된다. 이에 따라, 제2 전극(273) 및 캡핑층(280)은 제2 패턴

(273b, 280b)이 생략되거나, 제1 패턴(273a, 280a)이 유기발광소자(270)은 물론 제1 댐(121)까지 덮도록 형성될 수 있다. 이와 같은 경우에도 제1 패턴(273a, 280a)과 제3 패턴(273c, 280c)은 이격 배치되어야 한다.

[0145] 이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시예로 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형 실시될 수 있다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 보호 범위는 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

[0146] 100: 표시장치 110: 표시패널

111: 제1 기판 112: 제2 기판

120: 댐 140: 소스 드라이브 IC

150: 연성필름 160: 회로보드

170: 타이밍 제어부 210: 박막 트랜지스터

211: 액티브층 212: 게이트전극

213: 소스전극 214: 드레인전극

220: 커패시터 221: 하부 전극

222: 상부 전극 230: 게이트 절연막

240: 층간 절연막 250: 평탄화막

260: 뱅크 270: 유기발광소자

271: 제1 전극 272: 유기발광층

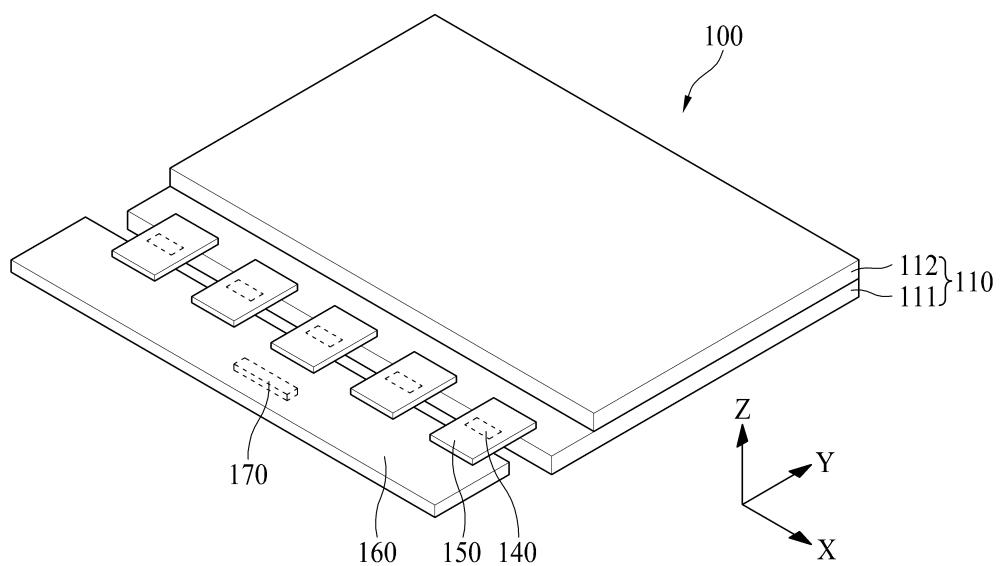
273: 제2 전극 280: 캡핑층

290: 봉지막 291: 제1 무기막

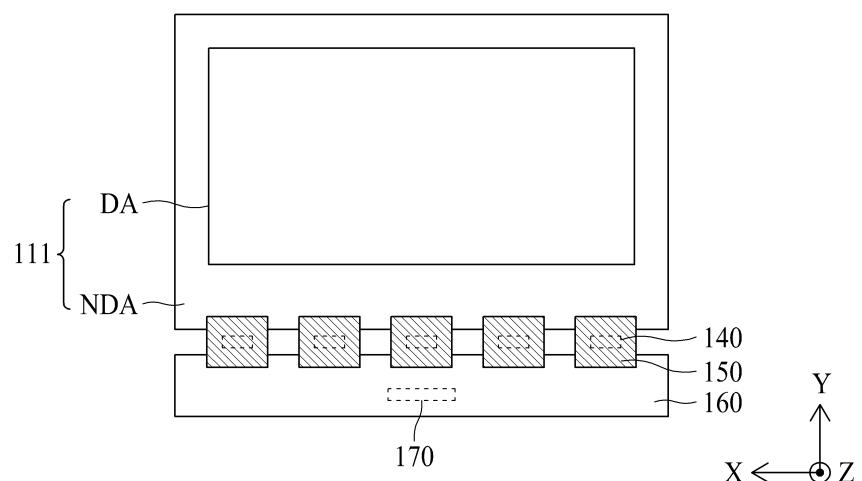
292: 유기막 293: 제2 무기막

도면

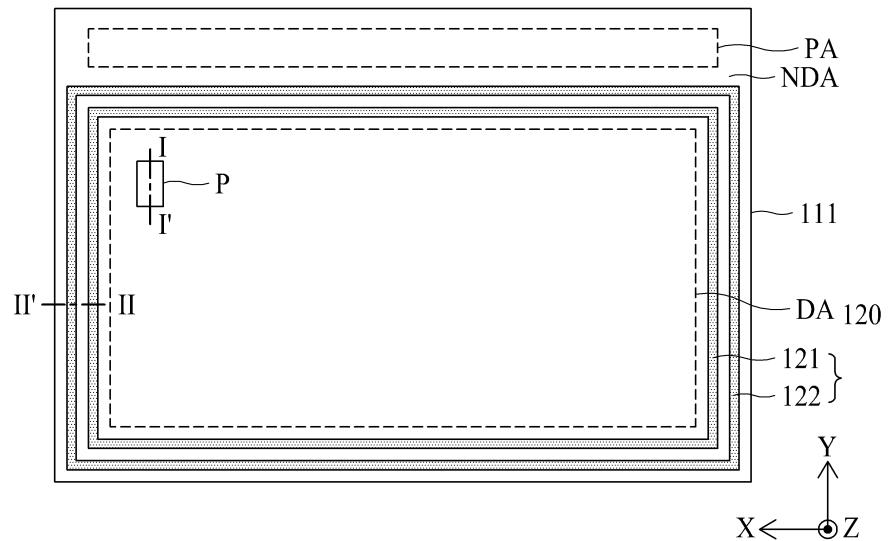
도면1



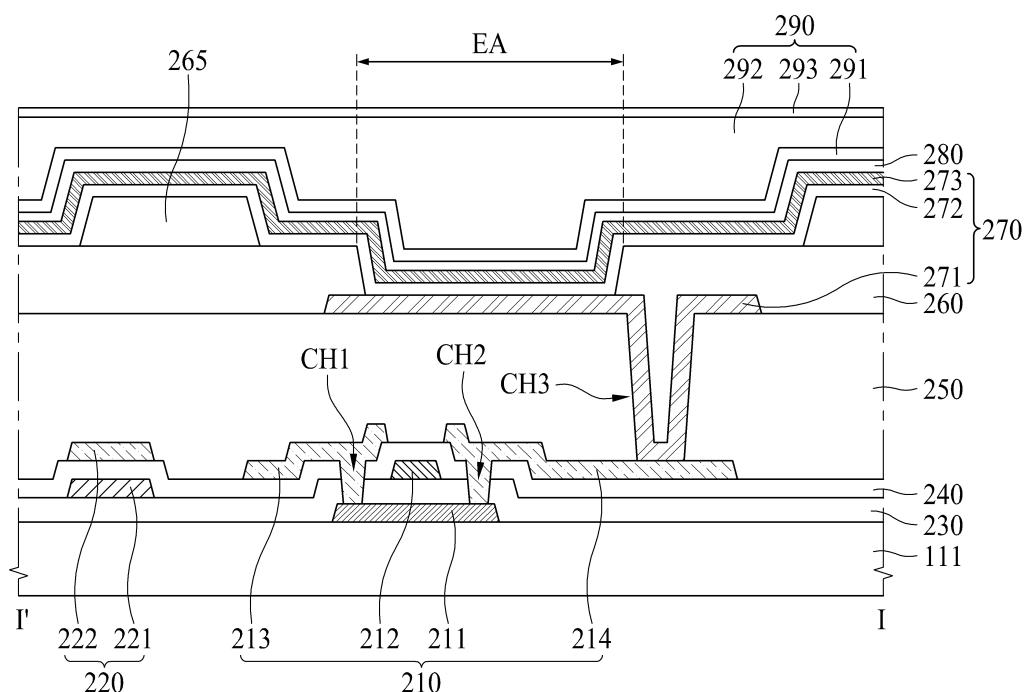
도면2



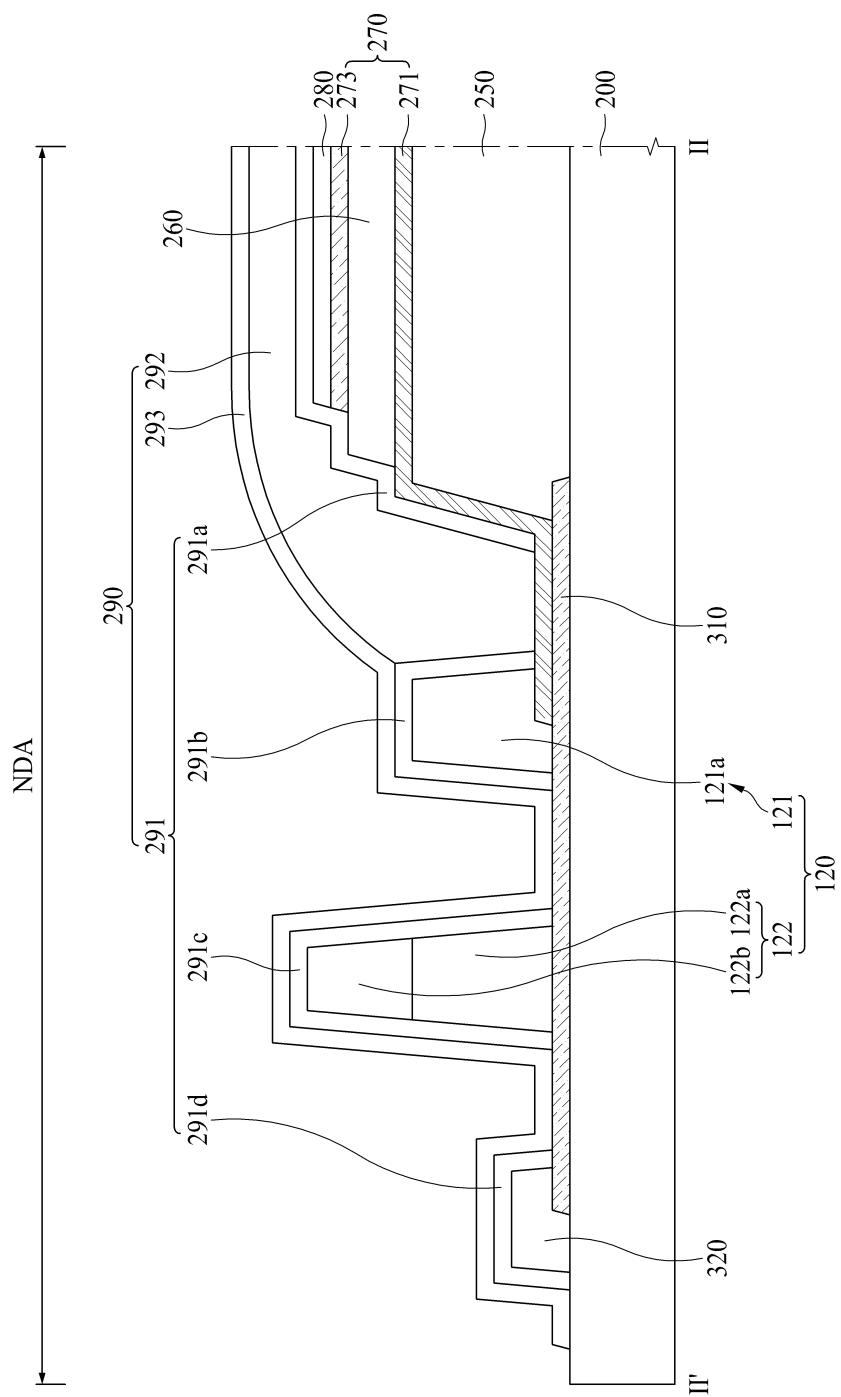
도면3



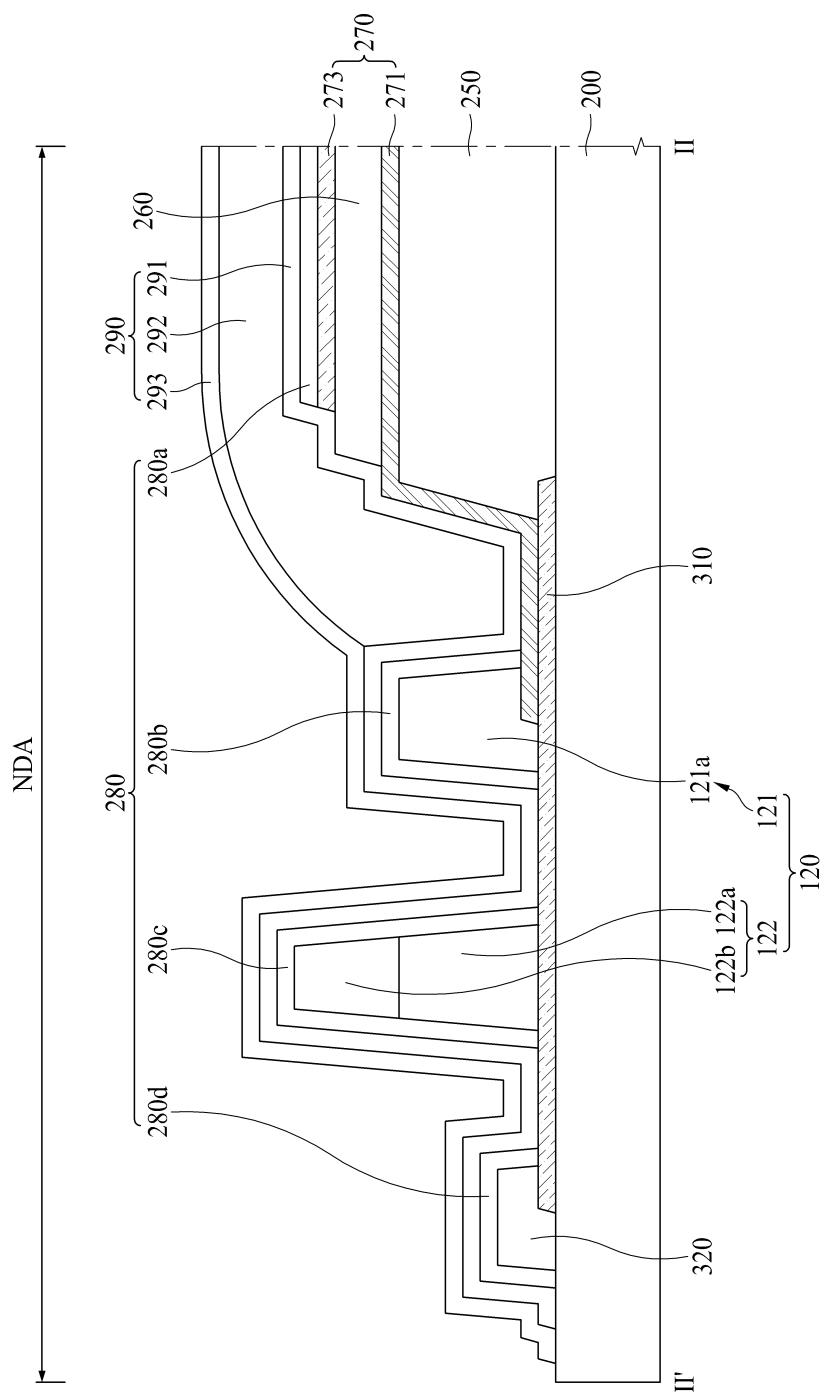
도면4



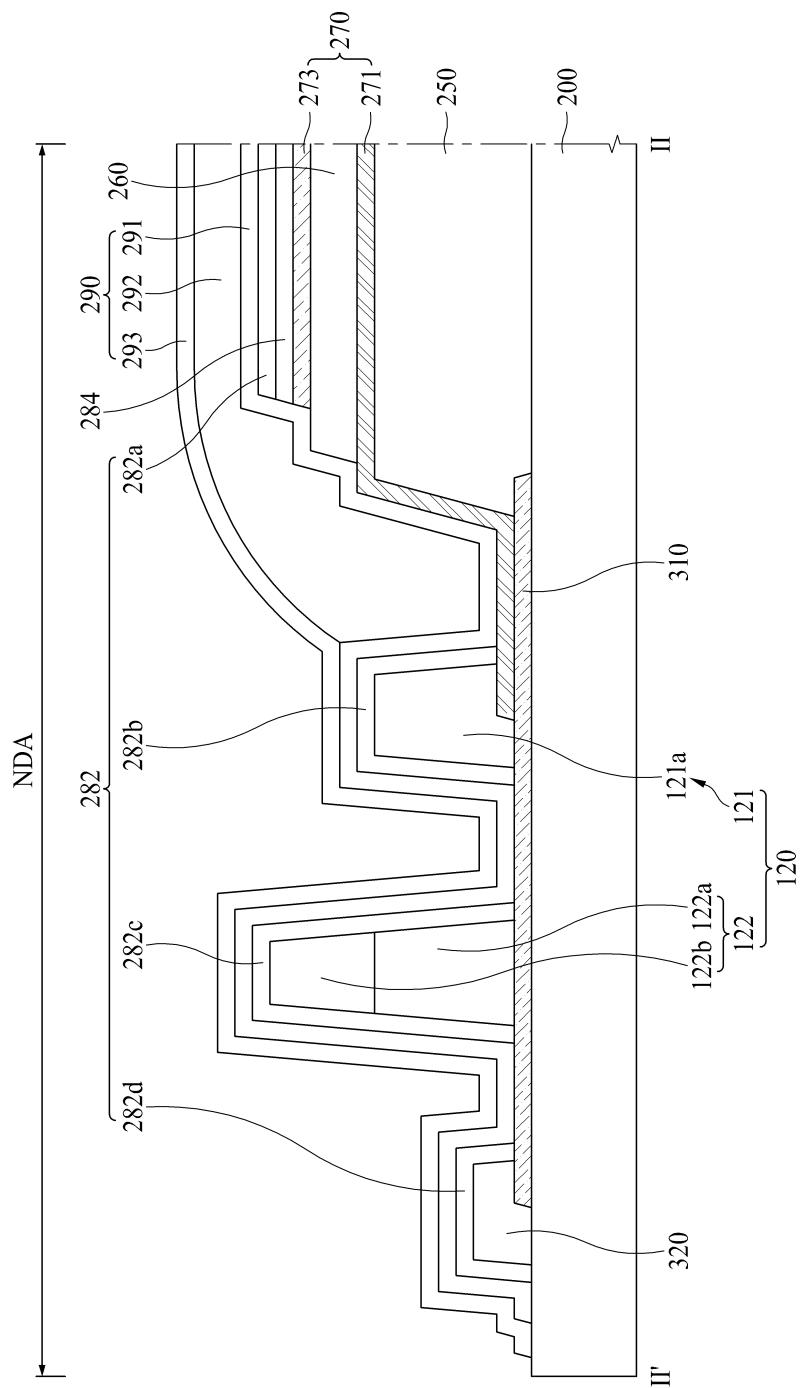
도면5



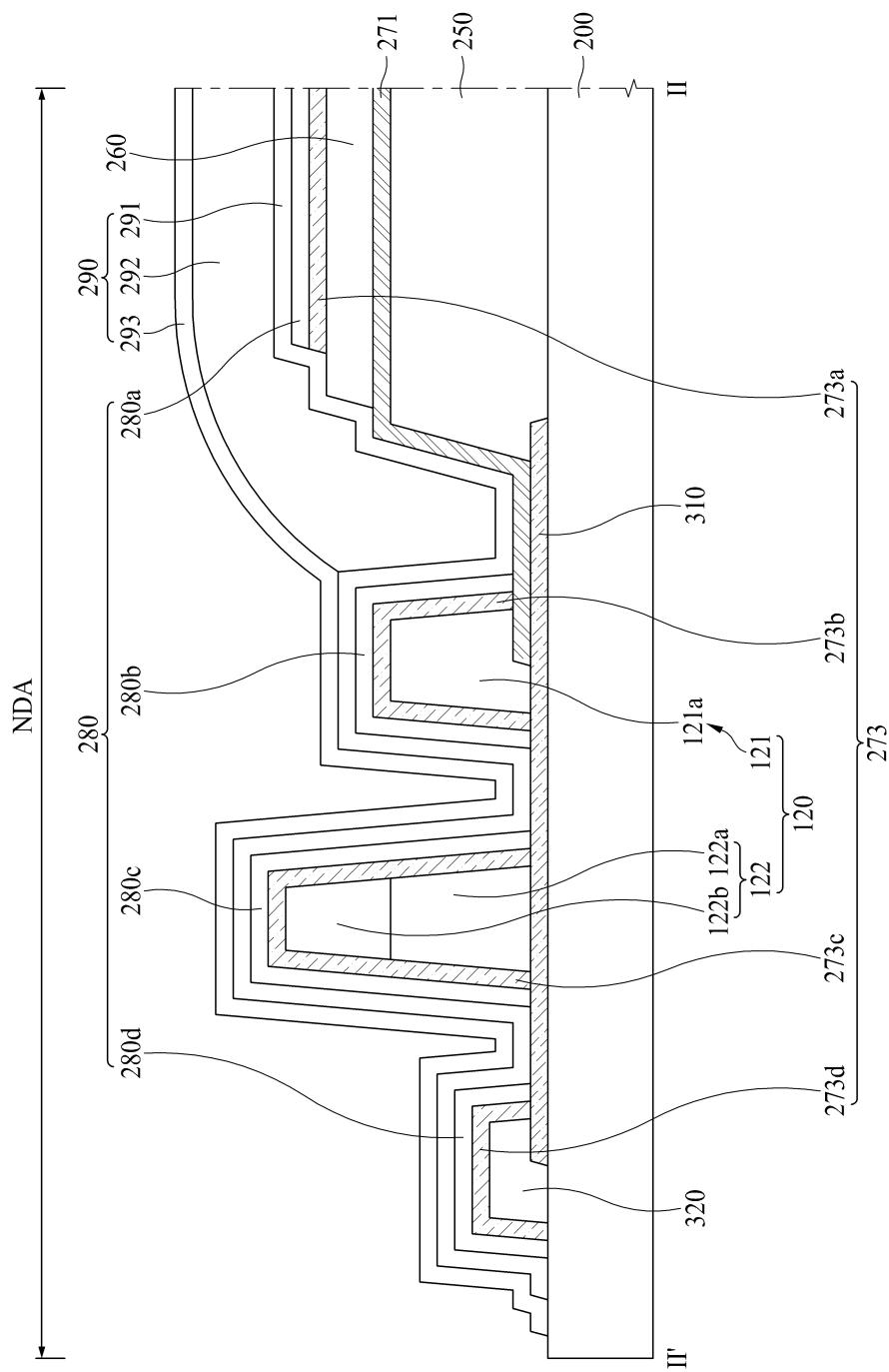
도면6



도면7



도면8



专利名称(译)	显示设备		
公开(公告)号	KR1020190075503A	公开(公告)日	2019-07-01
申请号	KR1020170177133	申请日	2017-12-21
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	김태경		
发明人	김태경		
IPC分类号	H01L51/52 H01L51/56		
CPC分类号	H01L51/5237 H01L51/5203 H01L51/56		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供一种显示装置，其能够防止水分扩散到设置在显示区域中的有机发光元件。根据实施例的显示装置包括：基板，其包括显示区域和围绕该显示区域的非显示区域；有机发光元件，其布置在该显示区域中并且包括第一电极，有机发光层和第二电极。电极，形成为围绕非显示区域中的显示区域的堤坝，在有机发光元件上构图的第一图案以及在堤坝上构图的第二图案，该第二图案具有与第一图案相同的材料。

